

10. 早期卒業について

優れた成績を収めた学生は、学士課程に3年以上4年未満の在学で卒業できます。早期卒業の希望を持ち多くの授業科目を優れた成績で修得できる学生については、その能力、適正に応じた教育を行うという観点から、一律に在学期間を4年とするのではなく、大学が適切と認めた学生が早期に大学を卒業して、我が国の大学院のみならず、諸外国の大学院にも進学し、あるいは社会の各方面で活躍できるよう、4年未満の在学で卒業できる制度です。

早期卒業の希望及び早期卒業に当たっては、次のような条件に該当することが必要です。

1. 早期卒業を希望できる者（早期卒業適格者）

在学期間が2年6月又は3年に達する日の属する学期末において、GPTが3.50以上であり、かつ、学士特定課題研究の履修資格の要件（P.84「2.（1）」参照）を満たしていること。

2. 早期卒業の要件

早期卒業適格者の認定を受け、所定の授業科目を履修し、学院の定める124単位以上の単位数を修得し、かつ、成績が優秀であること並びに「①学士特定課題研究及び学士特定課題プロジェクト」又は「②学士特定課題研究S」の審査に合格していること。

※早期卒業適格者の認定を受けた者の学士特定課題研究等の履修について

早期卒業希望者は、早期卒業適格者の認定を受けた後、卒業を目指す時期に応じて、2学期間（1年間）をかけて①「学士特定課題研究＋学士特定課題プロジェクト」を履修するか、1学期間（半年間）で②「学士特定課題研究S」を履修するかを選択します。なお、②の履修を開始した後でも、早期卒業希望の取り下げや早期卒業時期の変更により、①の履修に変更することが可能です。（P.85【卒業時期に応じた学士特定課題研究と学士特定課題研究Sの履修時期】参照）

※早期卒業適格者の「仮認定」について

在学期間3年で早期卒業し、卒業直後の4月に大学院修士課程への入学を希望する者であって、学士課程3年次相当の前期に大学院入学試験を受験する必要がある者については、在学期間が2年に達した時点で、早期卒業適格者の「仮認定」を受ける必要があります。「仮認定」を受けると、3年次相当の前期に研究プロジェクトを履修し、かつ卒業見込証明書の発行を受けることができます。「仮認定」を受けるためには、在学期間が2年に達する日に属する学期末において、GPTが3.00以上、かつ、90単位以上を修得していることが必要です。なお、「仮認定」を受けた場合であっても、早期卒業をするためには、改めて上述の早期卒業適格者の認定を受ける必要があります。

（注意）短期大学、高等専門学校からの編入学生は、早期卒業の対象外です。

上記のほか、早期卒業に関し必要な事項は、掲示等によるお知らせや、「東京科学大学早期卒業に関する規程」（P.244）を参照してください。また、早期卒業を希望する場合は、あらかじめアカデミック・アドバイザーや系主任に相談してください。

なお、早期卒業とは異なる制度として、いわゆる「飛び入学」の制度がありますが、飛び入学の場合、学士課程の卒業とはなりません。（P.41参照）